

熱物理学演義 No.10 (2025 年 12 月 17 日)

特に断らぬ限り, T は系の温度, p は系の圧力, V は系の体積, U は内部エネルギー, S はエントロピーを表す.

小テスト問題: 閉じた一成分系の Helmholtz の自由エネルギーを $F(T, V)$ とするとその完全微分は $dF = -SdT - pdV$ である. また, Gibbs の自由エネルギー $G(T, p)$ は, $F(T, V)$ を $G = F + pV$ と Legendre 変換することで得られる.

- (1) G の完全微分の表式を書き下せ.
- (2) F や G の二階偏微分が微分順序によらないことから次式を示せ.

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

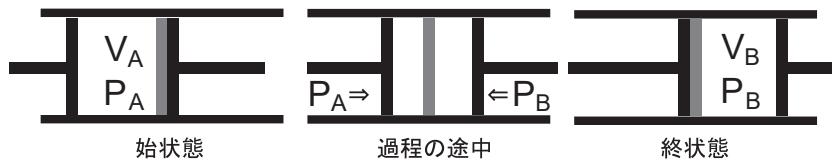
(3) (2) の結果と定積および定圧比熱に対する公式 $C_V = T(\partial S/\partial T)_V$, $C_p = T(\partial S/\partial T)_p$ に注意して, 以下の TdS 方程式を導け.

$$TdS = C_V dT + T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dV = C_p dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

ここまで小テスト

全問共通の説明

図のように断熱材でできた管が多孔質の栓 (スロットルバルブ) で二つの部分に隔てられており, 栓の左右には断熱材でできたピストンがついている. はじめ二つのピストンは両方とも固定され, 栓の左側のピストンと栓の間には体積 V_A , 圧力 p_A の平衡状態にある一成分気体が入っており, 栓の右側のピストンは栓に密着している (状態 A). つぎに, ピストンの固定を解除して, 栓の左側にあるピストンに一定外圧 p_A , 栓の右側にあるピストンに一定外圧 p_B を加える. $p_B < p_A$ であると, 気体は最終的にすべて栓の右側へ押し出されて, 体積 V_B , 圧力 p_B の平衡状態に達する (状態 B). この断熱過程を Joule-Thomson 過程と呼ぶ.



問題 1

- (1) 状態 A および B における気体のエンタルピーをそれぞれ H_A , H_B とするとき, $H_A = H_B$ を示せ.
ヒント: 热力学第一法則をもとに考えよ.
- (2) エンタルピー $H(S, p)$ の完全微分が $dH = TdS + Vdp$ であることに注意し, $(\partial S/\partial p)_H$ を T と V を用いて表せ.
- (3) Joule-Thomson 過程が不可逆であること, すなわち状態 B の気体のエントロピーが, 状態 A のエントロピーより大きいことを示せ.

裏へ

問題 2 : 外圧差 $p_A - p_B$ が小さければ、Joule-Thomson 過程による気体の温度変化を、

$$T_B - T_A = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H (p_B - p_A)$$

と評価できる。ここで現れる係数 $\mu_{JT} = (\partial T / \partial p)_H$ を Joule-Thomson 係数と呼ぶ。

- (1) $\mu_{JT} = -\frac{(\partial H / \partial p)_T}{(\partial H / \partial T)_p}$ を示せ。
- (2) $dH = TdS + Vdp$ から、 $(\partial H / \partial p)_T = T(\partial S / \partial p)_T + V$ を導け。
- (3) 小テスト (2) の結果と定圧比熱 C_p に対する公式 $C_p = (\partial H / \partial T)_p$ に注意して、

$$\mu_{JT} = \frac{TV}{C_p} \left(\alpha - \frac{1}{T} \right)$$

を導け。ただし $\alpha = V^{-1} (\partial V / \partial T)_p$ は体膨張率である。

問題 3 : 具体的に、状態方程式

$$\left(p + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right) (V - nb) = nRT$$

に従う van der Walls 気体 (a, b は微小な正の定数, n は物質量, R は気体定数) に Joule-Thomson 過程をおこなわせる。

- (1) 気体が希薄であるとして、気体の体膨張率 $\alpha(T, V)$ を密度 n/V の一次近似で求めよ。
- (2) Joule-Thomson 係数 μ_{JT} がゼロになる温度を逆転温度と呼ぶ。(1)で考えた希薄な van der Walls 気体に対し、逆転温度を n/V の最低次の近似で求めよ。問題 2(3) の結果を基に考えよ。
- (3) 逆転温度より高温および低温における μ_{JT} の正負を判定せよ。

[アドバンストクラス追加問題]

問題 4 : 外部との粒子数 N の移動を許した場合、第一法則は

$$TdS = dU + pdV - \mu dN$$

と変更を受ける。これを見ると、1 粒子あたりの化学ポテンシャル μ は粒子の移動によってなされる化学的な仕事と解釈できる。以下の問題を解き、 n モルの理想気体の化学ポテンシャルを求めよう。なお、 n モルの気体の粒子数 N は、気体定数 R 、ボルツマン定数 k_B を用いて $nR = Nk_B$ の関係にあることが知られている。

- (a) 理想気体の内部エネルギーは $U = Nc_v T$ と書ける。 c_v は 1 粒子あたりの定積熱容量である。 μ/T を T の関数として表せ。ただし T によらない関数を $f(V, N)$ として足しておくこと。
- (b) N を用いた理想気体の状態方程式は $pV = Nk_B T$ である。 μ/T を V の関数として求めよ。ただし V によらない関数を $g(T, N)$ として足しておくこと。
- (c) 上記二つの結果から $f(V, N)$, $g(T, N)$ を求めよ。ただし、条件だけでは決まらない共通部分を $f_0(N)$ とおくこと。
- (d) 得られた μ を p, T の関数として現そう。ギブス自由エネルギーの示量性より $\mu(p, T)$ は示強変数であることが知られている。このことから $f_0(N)$ を決定せよ。ただし、 $f_0(N=1)=0$ となるようにすること。